

(54) Zastosowanie układów hybrydowych MgO · SiO₂/wielościennie oligomeryczne silseskwioksy jako promotory ceramizacji w kompozytach silikonowych na osłony przewodów elektrycznych

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zastosowania układów hybrydowych MgO · SiO₂/ wielościennie oligomeryczne silseskwioksy jako promotorów ceramizacji w kompozytach silikonowych przeznaczonych na osłony przewodów elektrycznych. Układy hybrydowe zawierają krzemian magnezu oraz 0,1-50 części wagowych, korzystnie 10 części wagowych, silseskwioksanów jako modyfikatorów zawierających grupę i/lub grupy typu alkilowe-, lub alkoksy-, lub metakryloksy-, lub glicydoksy-, lub amino-, lub aminofenilo-, lub fenilo-, lub winylo-, lub perfluoro- lub ich mieszaniny.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 397200 (22) 2011 11 30

(51) H01B 5/10 (2006.01)

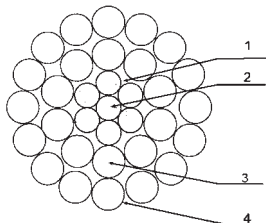
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KNYCH TADEUSZ; MAMALA ANDRZEJ; KAWECKI ARTUR; KWAŚNIEWSKI PAWEŁ; KISIEWICZ GRZEGORZ; SMYRAK BEATA

(54) Przewód do elektroenergetycznych linii napowietrznych

(57) Przewód do elektroenergetycznych linii napowietrznych zawierający rdzeń nośno-przewodzący oraz warstwy zewnętrzne nałożone na rdzeń nośno-przewodzący, charakteryzuje się tym, że rdzeń nośno-przewodzący (1) wykonany jest ze stopów miedzi o wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej co najmniej 1000 MPa i przewodności elektrycznej wynoszącej co najmniej 62% IACS, zaś warstwy zewnętrzne (4) wykonane są z aluminium w stanie miękkim wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej od 40 MPa do 100 MPa i przewodności elektrycznej wynoszącej co najmniej 61,8% IACS.

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) 397208 (22) 2011 12 01

(51) H01C 10/14 (2006.01)
H01L 31/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole

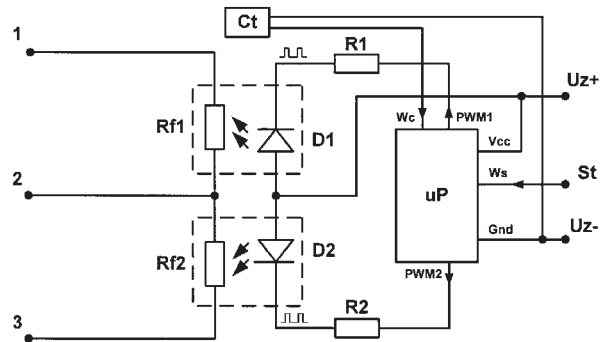
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW

(54) Potencjometr cyfrowy

(57) Potencjometr cyfrowy charakteryzuje się tym, że wejście pierwsze (1) połączone jest z końcówką pierwszą szeregowo połączonych fotorezystorów: pierwszego (Rf1) i drugiego (Rf2), a wejście drugie (2) połączone jest z węzłem wspólnym fotorezystorów: pierwszego (Rf1) i drugiego (Rf2), zaś wejście trzecie połączone jest z końcówką drugą szeregowo połączonych fotorezystorów: pierwszego (Rf1) i drugiego (Rf2), dioda elektroluminescencyjna pierwsza (D1) jest sprzężona optycznie z fotorezystorem pierwszym (Rf1), a dioda elektroluminescencyjna druga (D2) jest sprzężona optycznie z fotorezystorem drugim (Rf2), przy czym anody diod elektroluminescencyjnych: pierwszej (D1) i drugiej (D2) połączone są z wejściem zasilającym dodatnim (Uz+), a katoda diody elektroluminescencyjnej pierwszej (D1) połączona jest z końcówką pierwszą rezystora pierwszego (R1), którego końcówka druga połączona

jest z wyjściem sterującym pierwszym (PWM1) mikrokontrolera (uP) i katoda diody elektroluminescencyjnej drugiej (D2) połączona jest z końcówką pierwszą rezystora drugiego (R2), którego końcówka druga połączona jest z wyjściem sterującym drugim (PWM2) mikrokontrolera (uP).

(2 zastrzeżenia)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2012 10 08

A1 (21) 397241 (22) 2011 12 05

(51) H01F 38/26 (2006.01)
H01F 38/36 (2006.01)

(71) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) WESOŁOWSKI ZBIGNIEW; TARNOWSKI MARCIN; DĘBSKI PAWEŁ; GRYSZTAR PAWEŁ; DUZDOWSKI JAROSŁAW

(54) Sposób wykonywania izolacji cewki napięciowej przekładnika WN i przyrząd do wykonywania izolacji cewki napięciowej

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że na zaizolowane uzwojenia cewki napięciowej (10) nakłada się ekran górny (17), który łączy się z prętem przewodzącym przepustu i następnie cewkę oraz miejsce połączenia cewki napięciowej (10) i przepustu, bandażuje się wstęgami papieru nawojowego w pionowej pozycji ułożenia cewki (10), naprzemiennie od strony górnej i dolnej powierzchni cewki. Przyrząd charakteryzuje się tym, że zawiera poprzeczkę i środki do ustalenia położenia cewki napięciowej (10) na poprzeczce, a poprzeczka zamocowana jest obrotowej ramy połączonej korpusem i podstawą.

(11 zastrzeżeń)

